



Расположение выводов
 вывод 1 - затвор;
 вывод 2 - сток;
 вывод 3 - исток

Масса не более 9,5 г

1 Основные технические данные
 1.1 Основные электрические параметры
 Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма		Температура корпуса, °С
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
Начальный ток стока, мкА ($U_{си} = 800 В, U_{зи} = 0 В$ 2П707В2; $U_{си} = 200 В, U_{зи} = 0 В$ 2П767В2, 2П793А4; $U_{си} = 100 В, U_{зи} = 0 В$ 2П769В2, 2П790А4; $U_{си} = 500 В, U_{зи} = 0 В$ 2П770К2, 2П795А4; $U_{си} = 60 В, U_{зи} = 0 В$ 2П782Ж2)	$I_{с.нач}$	—	25	25 ± 10
		—	25	
		—	25	
		—	25	
		—	25	
Начальный ток стока, мкА ($U_{си} = 640 В, U_{зи} = 0 В$ 2П707В2; $U_{си} = 160 В, U_{зи} = 0 В$ 2П767В2, 2П793А4; $U_{си} = 80 В, U_{зи} = 0 В$ 2П769В2, 2П790А4; $U_{си} = 400 В, U_{зи} = 0 В$ 2П770К2, 2П795А4; $U_{си} = 48 В, U_{зи} = 0 В$ 2П782Ж2)	$I_{с.нач}$	—	250	125 ± 5
		—	250	
		—	250	
		—	250	
		—	250	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	
<p>Начальный ток стока, мкА $(U_{си} = 720 \text{ В}, U_{зи} = 0 \text{ В } 2П707В2;$ $U_{си} = 160 \text{ В}, U_{зи} = 0 \text{ В } 2П767В2, 2П793А4;$ $U_{си} = 85 \text{ В}, U_{зи} = 0 \text{ В } 2П769В2, 2П790А4;$ $U_{си} = 400 \text{ В}, U_{зи} = 0 \text{ В } 2П770К2, 2П795А4;$ $U_{си} = 45 \text{ В}, U_{зи} = 0 \text{ В } 2П782Ж2)$</p>	$I_{с.нач}$	—	25	-60 ± 3	
<p>Крутизна характеристики, См $(U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 2,5 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс},$ $Q \geq 100 \text{ } 2П707В2;$ $U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 11 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс},$ $Q \geq 100 \text{ } 2П767В2;$ $U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 10 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс},$ $Q \geq 100 \text{ } 2П769В2;$ $U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 4 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс},$ $Q \geq 100 \text{ } 2П770К2;$ $U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 16 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс},$ $Q \geq 100 \text{ } 2П782Ж2;$ $U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 25 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс},$ $Q \geq 100 \text{ } 2П790А4;$ $U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 18 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс},$ $Q \geq 100 \text{ } 2П793А4;$ $U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 8 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс},$ $Q \geq 100 \text{ } 2П795А4)$</p>	S	2,5	—	20 ± 5	
	6,0	—			
	7,8	—			
	4,9	—			
	15	—			
	11	—			
	10	—			
	9,3	—			
	<p>Ток утечки затвора, нА $(U_{зи} = 20 \text{ В}, U_{си} = 0 \text{ В};$ $U_{зи} = -20 \text{ В}, U_{си} = 0 \text{ В})$</p>	$I_{з.ут}$	—	100	25 ± 10
	<p>Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом $(U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 2,5 \text{ А}, \tau_{и} \leq 1000 \text{ мкс } 2П707В2;$ $U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 11 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс } 2П767В2;$ $U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 10 \text{ А}, \tau_{и} \leq 1000 \text{ мкс } 2П769В2;$ $U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 4 \text{ А}, \tau_{и} \leq 1000 \text{ мкс } 2П770К2;$ $U_{зи} = 15 \text{ В}, I_c = 16 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс } 2П782Ж2;$ $U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 25 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс } 2П790А4;$ $U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 18 \text{ А}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс } 2П793А4;$ $U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 8 \text{ А}, \tau_{и} \leq 1000 \text{ мкс } 2П795А4)$</p>	$R_{си.отк}$	—	3	25 ± 10
		—	0,18		
		—	0,077		
		—	0,85		
		—	0,040		
		—	0,055		
		—	0,085		
		—	0,4		
<p>Пороговое напряжение, В $(U_{зи} = U_{зи}, I_c = 250 \text{ мкА})$</p>	$U_{зи.пор}$	1,5	6,0	25 ± 10	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
Постоянное прямое напряжение диода, В ($I_{и} = 4,1 \text{ А}, U_{зи} = 0 \text{ В}, \tau_{и} \leq 1000 \text{ мкс}$ 2П707В2; $I_{и} = 16 \text{ А}, U_{зи} = 0 \text{ В}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс}$ 2П767В2; 2П782Ж2; $I_{и} = 14 \text{ А}, U_{зи} = 0 \text{ В}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс}$ 2П769В2; 2П795А4; $I_{и} = 8 \text{ А}, U_{зи} = 0 \text{ В}, \tau_{и} \leq 1000 \text{ мкс}$ 2П770К2; $I_{и} = 30 \text{ А}, U_{зи} = 0 \text{ В}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс}$ 2П790А4; $I_{и} = 25 \text{ А}, U_{зи} = 0 \text{ В}, \tau_{и} \leq 300 \text{ мкс}$ 2П793А4)	Уис	—	1,8	25 ± 10
		—	2,0	
		—	2,5	
		—	2,5	
		—	2,0	
		—	2,0	
		—	2,5	
		—	2,0	

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

2П707В2 золото — 53,6108 г,
 серебро — 79,1150 г,
 2П767В2, 2П769В2 золото — г,
 серебро — г,
 2П770К2 золото — г,
 серебро — г,
 2П782Ж2 золото — г,
 серебро — г,
 2П790А4 золото — г,
 серебро — г,

2П793А4 золото —

г,

серебро —

г,

2П795А4 золото —

г,

серебро —

г,

в том числе для транзисторов:

2П707В2, 2П767В2, 2П769В2, 2П770К2, 2П782Ж2

золото —

0,00044

г/мм на 3 выводах длиной $(11,7 \pm 0,25)$ мм;

2П790А4, 2П793А4, 2П795А4 золото —

г/мм на

3 выводах длиной $(13,9 \pm 0,25)$ мм.

1.3 Содержание цветных металлов в одном транзисторе:

2П707В2, 2П767В2, 2П769В2, 2П770К2, 2П782Ж2 медь —

г в кор-

пусе;

2П790А4, 2П793А4, 2П795А4 медь —

г в корпусе.

2 Надежность

2.1 Минимальная наработка транзисторов ($T_{н.м}$) в режимах и условиях, допускаемых ТУ, при максимально допустимой температуре кристалла не более 150°C , — 25000 ч.

2.2 Минимальная наработка транзисторов в облегченных режимах, при температуре кристалла не более 95°C , — 50000 ч.

2.3 Групповой показатель безотказности — интенсивность отказов при испытании в течение наработки в режимах и условиях, допускаемых ТУ, ($\lambda_{г}$) при доверительной вероятности $P^* = 0,6$ не более $2 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.

2.4 Минимальный срок сохраняемости — 25 лет по ГОСТ В 28146-89.

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества каждого транзистора требованиям АЕЯР.432140.273ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных ГОСТ В 28146-89 и АЕЯР.432140.273ТУ.

Гарантийный срок — 25 лет.

Гарантийный срок исчисляется с даты изготовления транзисторов, а для транзисторов, подвергавшихся перепроверке, — с даты их перепроверки.